

DHA[®]

QJ/DHA 09.17-2018

11N90

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

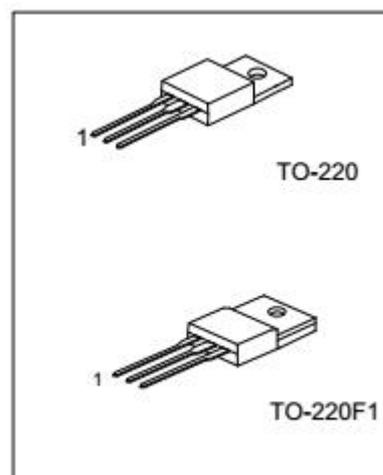
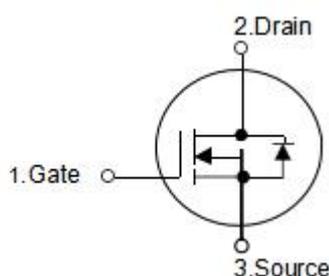
描述

11N90 是一款 N 沟道增强型功率 FET，采用先进技术，为客户提供平面条纹和 DMOS 技术。该技术专注于实现最小的导通电阻和卓越的开关性能。它还可以承受雪崩和换向模式下的高能脉冲。

用途

11N90 普遍应用于高效开关模式电源。

等效电路图

电参数 (T_{amb} = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	900	-	-	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA
I _D	漏极连续电流	A	-	-	11.0	T _j = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.91	1.1	V _{GS} = 10 V, I _D = 5.5 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	3.0	-	5.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	10	V _{DS} = 900 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V _{GS} = ± 30 V, V _{DS} = 0 V
T _j	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				